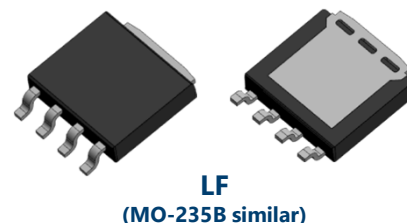


高速スイッチング・低ノイズ化を実現する 小型・大電流パワーMOSFET

小型・大電流パワーMOSFET EETMOS®5 / EETMOS®6シリーズ

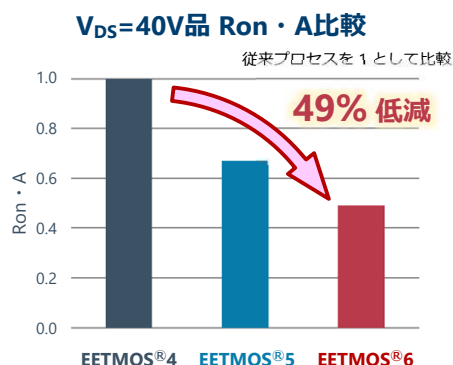


本シリーズは、従来のEETMOS®3 / EETMOS®4シリーズのトレンチゲート構造を大幅に改善し、低Qg・低ノイズを実現しました。
また、従来のEETMOS®4シリーズでも実績のあるCuクリップ構造の採用などにより、Ron・A比較で約49%低減しております。



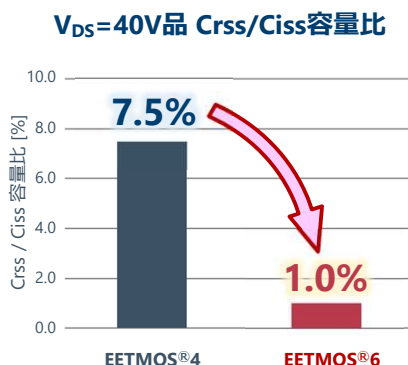
従来品とのRon・A比較

低Ron効果により低損失・高効率を実現しました。



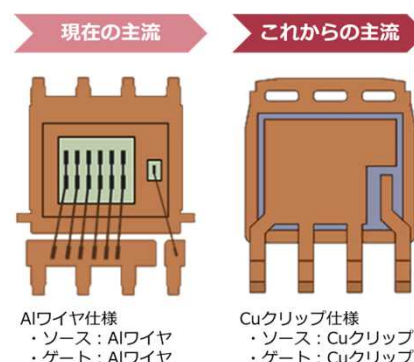
従来品との容量比比較

Crss/Ciss特性を改善し、セルフターンオンのリスクを大幅に低減しました。



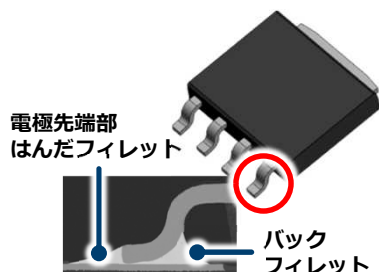
Cuクリップ構造採用

大幅な低抵抗化・放熱性向上で、小型化・オン抵抗の削減を実現しました。



ガルウィング形状のリード

基板応力緩和とはんだ濡れ視認性向上で高信頼性実装を実現しました。



Part Name	V _{DS} min [V]	I _D max [A]	V _{TH} typ [V]	Ron [mΩ]				Ciss* [pF]	Coss* [pF]	Crss* [pF]	Status
				V _{GS} =10V		V _{GS} =4.5V					
				typ	max	typ	max				
P33LF4RMK	40	33	3.0	8.3	10.4	—	—	740	237	8	Planning
P83LF4RMK	40	83	3.0	2.5	3.2	—	—	2215	681	22	Planning
P136LF4RMK	40	136	3.0	1.38	1.83	—	—	3880	1244	40	Planning
P180LF4RMK	40	180	3.0	0.67	0.84	—	—	6754	2165	70	RS
P26LF6GLK	60	26	2.0	22	30	14.7	18.4	581	304	42.8	ES
P56LF6GMK	60	56	3.0	5.9	7.3	—	—	1615	1099	94	ES
P58LF6GLK	60	58	2.0	5.4	6.7	9.6	12.8	1615	1099	94	ES
P88LF6GMK	60	88	3.0	3.2	4.0	—	—	2764	1882	160	ES
P90LF6GLK	60	90	2.0	3.1	3.8	5.4	7.2	2764	1882	160	ES
P120LF6GLK	60	120	2.0	1.7	2.3	2.88	3.84	4800	2111	107	ES
P120LF6GMK	60	120	3.0	1.83	2.3	—	—	4950	2079	75	ES

* 測定条件: V_{DS}=25V

新電元半導体製品の詳細情報はこちら

<https://www.shindengen.co.jp/products/semi/>

